

Spezifikationen	
Teilenummer	JAN1N6474US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	TVS DIODE 30.5VWM GSQMELF
Kategorie	Schaltkreisschutz > TVS - Dioden
Teilstatus	2538 pcs Stock
Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ)	30.5V
Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp	47.5V
Spannung - Aufteilung (min.)	33V
Unidirektionale Kanäle	1
Art	Zener
Supplier Device-Gehäuse	G-MELF (D-5C)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/552
Stromleitungsschutz	No
Power - Peak Pulse	1500W (1.5kW)
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, G
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs)	181A (8/20µs)
Kapazität @ Frequenz	-
Anwendungen	General Purpose

sein:

JAN1N6476
Microsemi Corporation
TVS DIODE 51.6VWM GPKG
AXIAL

 **JAN1N6472US**
Microsemi Corporation
TVS DIODE 15VWM 26.5VC
GSQMELF




JAN1N6475US
Microsemi Corporation
TVS DIODE 40.3VWM GSQMELF

 **Microsemi**

JAN1N6473US
Microsemi Corporation
TVS DIODE 24VWM 41.4VC
GSQMELF

 **JAN1N6485US**
Microsemi Corporation
DIODE ZENER 3.3V 1.5W D5A

Mehr

Schlüsselwort	JAN1N6474US Datenblatt	JAN1N6474US-Datenblätter	JAN1N6474US PDF	Microsemi JAN1N6474US
JAN1N6474US Electronic	JAN1N6474US-Komponenten	JAN1N6474US-Verteiler	JAN1N6474US-Bild	JAN1N6474US-Teil
JAN1N6474US Preis	JAN1N6474US Hersteller	JAN1N6474US Bild	JAN1N6474US Aktie	JAN1N6474US Inventar
JAN1N6474US Neu	JAN1N6474US Original	JAN1N6474US garantiert	JAN1N6474US RFQ	JAN1N6474US Online bestellen